- Duración del examen: 1 hora 45 minutos.
- La solución a cada ejercicio debe escribirse en el espacio reservado para ello en el propio enunciado.
- No podéis utilizar calculadora, móvil, apuntes, ...
- La solución al examen se publicará mañana en Atenea y las notas se publicarán en una semana

Ejercicio 1 (1,5 puntos)

Cada uno de los apartados pregunta sobre un ciclo concreto de la ejecución de una instrucción en el SISC Von Neumann. Escribid el valor de los bits de la palabra de control que genera el bloque SISC CONTROL UNIT durante el ciclo a que hace referencia cada apartado. Poned x siempre que no se pueda saber el valor de un bit (ya que no sabemos cómo se han implementado las x en la ROM_OUT). Para cada apartado/fila se indica el nodo/estado de la UC en ese ciclo y la instrucción (en ensamblador) que está almacenada en el IR en ese ciclo.

	<u>a</u>			Palabra de Control														
Apartado	Nodo/Estado (Mnemo Salida)	Instrucción en IR (en ensamblador)	@A	@B	Pc/Rx	N/N OP	F	P/I/L/A	@D	WrD	J.	Rd-In Wr-Mem	Ldlr	LdPc	Byte	R@/Pc	N (hexa)	ADDR-IO (hexa)
a	D	JALR R5, R3																
b	Movhi	MOVHI R2, 0x85																
c	Addr	LDB R1, 3(R1)																

Ejercicio 2 (2 puntos)

Indicad qué cambios se producen en el estado en el SISC Von Neumann después de ejecutar cada una de las instrucciones de la tabla suponiendo que antes de ejecutarse cada una de ellas PC=0x1234, Ri=0x7788 y que el contenido de todas las direcciones pares de la memoria es 0x85 y el de las impares es 0xAA. Utilizad el mnemotécnico $MEM_b[...] = ...$ y/o $MEM_w[...] = ...$ para indicar cambios en la memoria.

Instrucción a ejecutar	Cambios en el estado del computador
LD R1, 10(R6)	
MOVI R1, 0xFA	
BNZ R3, 8	
STB 3(R5), R3	

Ejercicio 3 (1 punto)

Completad las filas y columnas de la siguiente tabla que representa un subconjunto de la ROM_OUT de la unidad de control del SISC Von Neumann. Poned x siempre que un bit pueda valer tanto 0 como 1.

@ROM	Bz	M×F	WrD	R@/PC	Pc/Rx	LdIR	Ry/N	Estado
3								Cmp
5								Addr
9								Stb
12								Bnz

Ejercicio 4 (3 puntos)

El programa ensamblador de la derecha se ha traducido a lenguaje máquina para ser ejecutado en el SISC Von Neumann, situando la sección .text a partir de la dirección 0x1000 de memoria y justo a continuación la sección .data.

- a) Una vez cargado el programa en memoria:
 - ¿A qué dirección de memoria corresponde la etiqueta, o dirección simbólica, V1? (0,25 puntos)

$$V1 = 0x$$

• ¿Cuál es el word almacendo en las siguientes direcciones de memoria? (0,5 puntos)

```
Mem_W[0x1002] = 0x
Mem_W[0x100E] = 0x
```

b) Una vez ejecutado el programa en el computador SISC Von Neumann ¿Cuál es la dirección de memoria escrita por la instrucción ST?¿Cuál es el valor escrito? (1 punto)

```
Mem_W[0x] = 0x
```

```
FLAG = -1
.data
MAGIC: .word 0x89FF
V1:
        .word 1, 2, 4, 8, 16
        .word 32, 64, 128, 256
        .word FLAG
V2:
        .word 0
.text
       IVOM
              R0, lo(V1)
       MOVHI RO, hi(V1)
       IVOM
              R1, lo(FLAG)
       MOVHI R1, hi(FLAG)
       IVOM
              R2, 0
L1:
       LD
              R3, 0(R0)
       CMPEQ R4, R3, R1
              R4, L2
       BNZ
       ADD
              R2, R2, R3
       ADDI
              R0, R0, 2
       BZ
              R4, L1
              R7, lo(V2)
L2:
       MOVI
       MOVHI R7, hi(V2)
       ST
              0(R7), R2
.end
```

c) Indicad el número total de instrucciones ejecutadas por el código de la sección .text y desglosadlo en instrucciones lentas y rápidas. Calculad el tiempo de ejecución para el computador Harvard uniciclo y el Von Neumann suponiendo que sus tiempos de ciclo son 2.500 y 1.000 u.t. respectivamente. Finalmente, ¿cuánto vale x para que sea cierta la afirmación: el computador Harvard uniciclo tarda un x % menos que el Von Neumann en ejecutar dicho código. ? (1 punto). Indicad tanto las operaciones como el resultado.

```
N_{total} = N_{rapidas} = N_{lentas} =
T_{ejec}(Harv.Uni.) =
T_{ejec}(VonNeu.) =
x =
```

d) Una vez ejecutada la instrucción ST, ¿qué hará el computador? (0,25 puntos)

Apellidos y nombre: Grupo: DNI:

Ejercicio 5 (2,5 puntos)

Completad el diseño del SISC Von Neumann para que ejecute, **además** de las instrucciones originales, 8 nuevas instrucciones LDESCk (k es un entero entre +3 y -4, es decir, LDESC+3, LDESC+2, ..., LDESC-3 y LDESC-4):

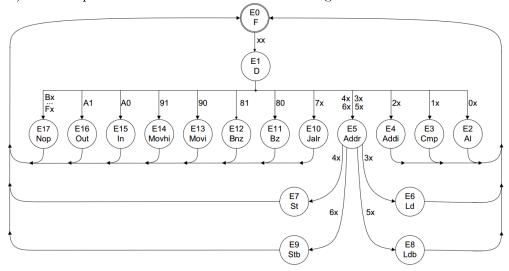
- Codificación: 1111 aaa bbb ddd kkk
- Sintaxis: LDESCk Rd, Ra, Rb
- Semántica: $Rd=Mem_W[Ra + Rb \times 2^k]$; donde k es la interpretación de los bits 2, 1 y 0 de la instrucción como un entero codificado en complemento a 2.

Para poder ejecutar las nuevas instrucciones, os proponemos que modifiquéis únicamente la ALU y el contenido tanto de la ROM_OUT como el de la ROM_Q+.

a) Indicad cómo modificaríais la tabla de funcionalidades de la ALU. (0,5 puntos)

	F			OP	() 1 /	
b_2	b_1	b_0	11	10	01	00
0	0	0		X	CMPLT(X,Y)	AND(X,Y)
0	0	1		Y	CMPLE(X,Y)	OR (X, Y)
0	1	0		MOVHI(X,Y)		XOR(X,Y)
0	1	1		X& (∼1)	CMPEQ(X,Y)	NOT(X)
1	0	0			CMPLTU(X,Y)	ADD(X,Y)
1	0	1			CMPLEU(X,Y)	SUB(X,Y)
1	1	0				SHA(X,Y)
1	1	1				SHL(X,Y)

b) Indicad qué modificaciones introduciríais en el grafo de estados de la unidad de control. (0,5 puntos)



c) Indicad la(s) dirección(es) de la ROM_Q+ (en binario) y su contenido (en hexadecimal) para implementar la transición que hayáis añadido desde el estado E1 (D). (0,5 puntos)

d) Indicad el contenido de las filas de la ROM_OUT que sea preciso modificar así como las acciones a realizar (la tabla adjunta tiene el número suficiente de filas, incluso es posible que no sean necesarias todas) (1 punto)

@ROM	Bnz	Bz	WrMem RdIn	WrOut	WrD	Ldlr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	P/I/L/A1	P/I/L/A0	OP1	OP0	M×N1	M×N0	MxF	F2	Ξ	6	Mx@D1	Mx@D0

Acciones asociadas al estado (en lenguaje de transferencia de registros)